

SCE 536 · SCE 538 · SCE 540



Silizium-npn-Epitaxial-Planar-NF-Transistoren für allgemeine Anwendungen in der Hybrid- und Aufsetztechnik

Bauform 4 SOT23

Wärmewiderstand

R_{thja} auf Cevaunit 1,5 mm dick, 2,5 cm² Fläche ≤ 160 K/W

auf Keramiksubstrat 0,7 mm dick, 2,5 cm² Fläche ≤ 125 K/W

| Absolute Grenzwerte | SCE 536 | SCE 538 | SCE 540 |
|---|---------|--------------|------------|
| $-U_{CBO}$ | 45 | 60 | 100 V |
| $-U_{CEO}$ | 45 | 60 | 80 V |
| $-U_{EBO}$ | | 5 | V |
| $-I_C$ | | 1 | A |
| $-I_{CM}$ | | 1,5 | A |
| $-I_B$ | | 0,1 | A |
| P_{tot} ($\vartheta_{amb} = 25^\circ C$) | | | |
| auf Cevaunit 1,5 mm dick, 2,5 cm ² Fläche | | 0,8 | W |
| auf Keramiksubstrat 0,7 mm dick, 2,5 cm ² Fläche | | 1 | W |
| ϑ_j | | 150 | $^\circ C$ |
| ϑ_{amb} | | -65 ... +150 | $^\circ C$ |
| ϑ_{stg} | | -65 ... +150 | $^\circ C$ |
| Kennwerte ($\vartheta_{amb} = 25^\circ C$) | | | |
| $-U_{CEsat}$ ($-I_C = 500$ mA, $-I_B = 50$ mA) | | $\leq 0,5$ | V |
| $-U_{BE}$ ($-U_{CE} = 2$ V, $-I_C = 500$ mA) | | ≤ 1 | V |
| $-I_{CBO}$ ($-U_{CB} = 30$ V) | | ≤ 100 | nA |
| $h_{21E}^{(1)}$ ($-U_{CE} = 2$ V, $-I_C = 5$ mA) | | > 25 | |
| h_{21E} ($-U_{CE} = 2$ V, $-I_C = 150$ mA) | Gr. A | 40 ... 100 | |
| | Gr. B | 63 ... 160 | |
| | Gr. C | 100 ... 250 | |
| $h_{21E}^{(1)}$ ($-U_{CE} = 2$ V, $-I_C = 500$ mA) | | > 25 | |
| f_T ($-U_{CE} = 5$ V, $-I_C = 10$ mA, $f = 20$ MHz) | | > 50 | MHz |

1) Messung erfolgt impulsmäßig, $\frac{t_p}{T} = 0,01$, $t_p = 0,03$ ms